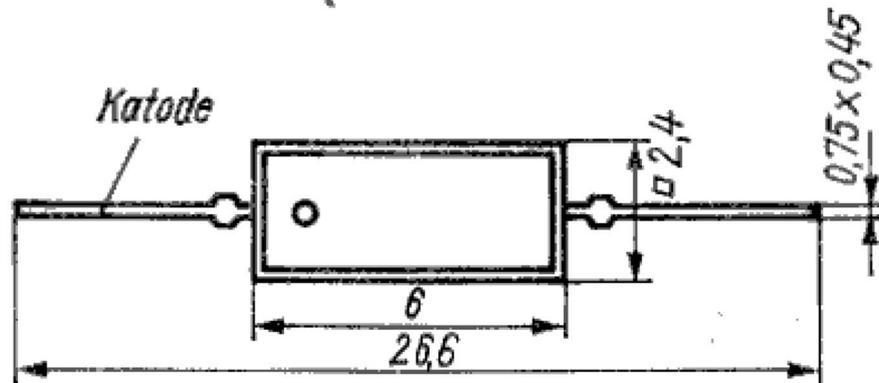


Silizium-Epitaxie-Diode im Plastikgehäuse zur elektronischen Bereichsumschaltung in VHF-Tunern



Grenzwerte

Sperrgleichspannung	U_R	20 V
Durchlaßgleichstrom bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$	I_F	80 mA
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	$-25 \dots +85^\circ\text{C}$
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	125 °C
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	100 mW

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung bei $I_F = 100\text{ mA}$	U_F	\leq	1,2 V
Sperrstrom bei $U_R = 20\text{ V}$	I_R	\leq	100 nA
diff. Durchlaßwiderstand bei $I_F = 10\text{ mA}$, $f = 30 \dots 300\text{ MHz}$	r_f	\leq	1 Ohm
Sperrschichtkapazität bei $U_R = 10\text{ V}$, $f = 0,5\text{ MHz}$	C_j	\leq	3,1 pF